

## SSD serie E1000

### Introducción

El SSD E1000 adopta la interfaz M.2, el chip informático de control SSD avanzado y el flash NAND 3D para mejorar de manera efectiva la velocidad R/W y garantizar la seguridad de los datos.



Se aplica a computadoras personales y servidores proxy de tamaño pequeño para brindar un servicio estable y de alta velocidad. También puede mejorar la experiencia de juego de alta gama y el rendimiento de edición de gráficos 3D.

### Modelos Disponibles

HS-SSD-E1000 128GB

HS-SSD-E1000 256GB

HS-SSD-E1000 512GB

HS-SSD-E1000 1024GB

### Aplicación Típica

- PC (Portátil y Escritorio)
- Servidor proxy de tamaño pequeño

### Características y Funciones

- **Alta velocidad R/W** Soporta  
Max. velocidad de lectura de hasta 2100 MB/s
- **3D NAND**  
Adopta flash 3D NAND para optimizar la capacidad, el rendimiento y la estabilidad
- **A prueba de choques**  
Sin estructura mecánica  
Adopta chips electrónicos  
Controla Alta seguridad de datos
- **Interfaz M.2**



## Especificaciones

Modelo	HS-SSD-E1000				
Capacidad	128GB	256GB	512GB	1024GB	
Forma de Factor	M.2(2280)				
Interfaz	PCIe Gen3x4				
Max. velocidad de lectura secuencial de 128 K ❶	980 MB/s	1900 MB/s	2000 MB/s	2100 MB/s	
Max. velocidad de escritura secuencial de 128 K	620 MB/s	1200 MB/s	1600 MB/s	1800 MB/s	
Max. IOPS de lectura aleatoria de 4 K ❷	40 K	85 K	125 K	135 K	
Max. IOPS de escritura aleatoria de 4 K	134 K	130 K	128 K	128 K	
Consumo de Potencia ❸	Lectura (RMS máx.)	6.4 W	7 W	7.2 W	5.9 W
	Escritura (RMS máx.)	3.9 W	5 W	6.1 W	6.1 W
Resistencia (TBW) ❹	80 TB	160 TB	320 TB	640 TB	
Memoria flash NAND	3D TLC				
Peso	≤ 8 g				
MTBF (tiempo medio entre fallos) ❺	1,500,000 h				
Temperatura de Operacion	0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)				
Humedad de Operación	5% a 95% (Sin condensación)				
Período de garantía limitada	3 años				

\*: La prueba de rendimiento se realiza en un entorno de prueba específico. Cualquier cambio de sistema informático, sistema operativo, hardware, software o funciones influirá en el resultado de la prueba.

❶ ❷: El rendimiento en las especificaciones se prueba basados en CrystalDiskMark.

❸: El consumo de energía puede variar según la configuración y la plataforma flash. Se miden los consumos de energía utilizando CrystalDiskMark 1000 MB para probar secuencial R/W 5 veces. Los consumos de energía se miden cuando son secuenciales

Leer [1/5] a [5/5] y escritura secuencial [1/5] a [5/5].

❹: El valor de TBW se calcula en función de la carga de trabajo de JEDEC 218B / 219A estándar.

❺: El valor MTBF se calcula en función de la tasa de falla funcional del estándar JEDEC 218B/219A

Distributed by



Headquarters  
Room 307, Unit B, Building 2,  
399 Danfeng Road, Binjiang District,  
Hangzhou, Zhejiang, China